

Список основных публикаций

Валерия Георгиевича Сидорова

1. Alexeev A. N., Chaly V. P., Krasovitsky D. M., Mamaev V. V., Petrov S. I., Sidorov V. G., Arcebashev N. S. Technology development for GaN based power microwave DHFET // Journal of Physics: Conference Series. 2016. - V. 690. - P. 012042/1-4.
DOI:10.1088/1742-6596/690/1/012042.
2. Алексеев А.Н., Красовицкий Д.М., Петров С.И., Чалый В.П., Мамаев В.В., Сидоров В.Г. Особенности использования аммиачной и плазменной МЛЭ для получения III-N НЕМТ гетероструктур // Физика и Техника Полупроводников. 2015. - Т. 49. №1. - С. 94-97.
3. Гребенщикова Е.А., Евстропов В.В., Ильинская Н.Д., Мельников Ю.С., Серебренникова О.Ю., Сидоров В.Г., Шерстнёв В.В., Яковлев Ю.П. Электрические свойства структур Рd-оксид-InP // Физика и Техника Полупроводников. 2015. - Т. 49. №3. - С. 376-378.
4. Железняк А.Г., Сидоров В.Г. Планшетный сканер как прибор для физических исследований // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. 2015. - №2(218). - С. 49-60.
5. Выращивание транзисторных гетероструктур на основе InAlN методом аммиачной и плазменной МЛЭ / В.В. Мамаев, В.Г. Сидоров, А.А. Алексеев, С.И. Петров, Д.М. Красовицкий, В.П. Чалый // Сборник трудов конференции Научный форум с международным участием «Неделя науки СПбГПУ», (Санкт-Петербург, 01-06 Декабря 2014 г.) Отв. ред. В.Э. Гасумянц, Д.Д. Каров. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 238-241.
6. Alexeev A. N., Chaly V. P., Krasovitsky D. M., Mamaev V. V., Petrov S. I., Sidorov V. G. Features and benefits of III-N growth by ammonia-MBE and plasma assisted MBE // Journal of Physics: Conference Series. 2014. - V. 541. - P. 012030/1-4.
DOI:10.1088/1742-6596/541/1/012030.
7. Алексеев А.Н., Петров С.И., Красовицкий Д.М., Чалый В.П., Мамаев В.В., Сидоров В.Г. Выращивание высокотемпературных буферных слоев AlN/AlGa_N для снижения плотности дислокаций в НЕМТ гетероструктурах на основе GaN // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2014. - №9(158). - С. 24-32.
8. Петров С.И., Алексеев А.Н., Красовицкий Д.М., Чалый В.П., Мамаев В.В., Сидоров В.Г. Слои GaN с пониженной плотностью дислокаций для НЕМТ транзисторов, выращенные NH₃-МБЕ с использованием высокотемпературных буферных слоев AlN/AlGa_N // Ученые записки физического факультета Московского университета. 2014. - Т. 1. №2(10). - С. 67-71.

9. Сидоров В.Г., Шмидт Н.П. Деградиционные явления и проблема надежности полупроводниковых источников излучения // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. 2013. - №2(170). - С. 71-80.
10. Мамаев В.В., Сидоров В.Г., Петров С.И., Алексеев А.Н. Получение слоев нитрида галлия с пониженной плотностью дислокаций // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Физико-математические науки. 2012. - №4(158). - С. 28-31.
11. Сидоров В.Г., Дрижук А.Г., Шагалов М.Д., Сидоров Д.В., Усиков А.С. Повышение эффективности i-n-GaN-светодиодов с помощью электрохимического травления // Письма в Журнал Технической Физики. 1999. - Т. 25. №2. - С. 55-60.
12. Сидоров В.Г., Сидоров Д.В., Соколов В.И. Влияние внутренних механических напряжений на характеристики светодиодов из арсенида галлия // Физика и Техника Полупроводников. 1998. - Т. 32. №11. - С. 1393-1398.